

## Si フォトダイオード フェムトワット フォトレシーバ



製品イメージ。製品には、ポストホルダ、ポストは含まれません。

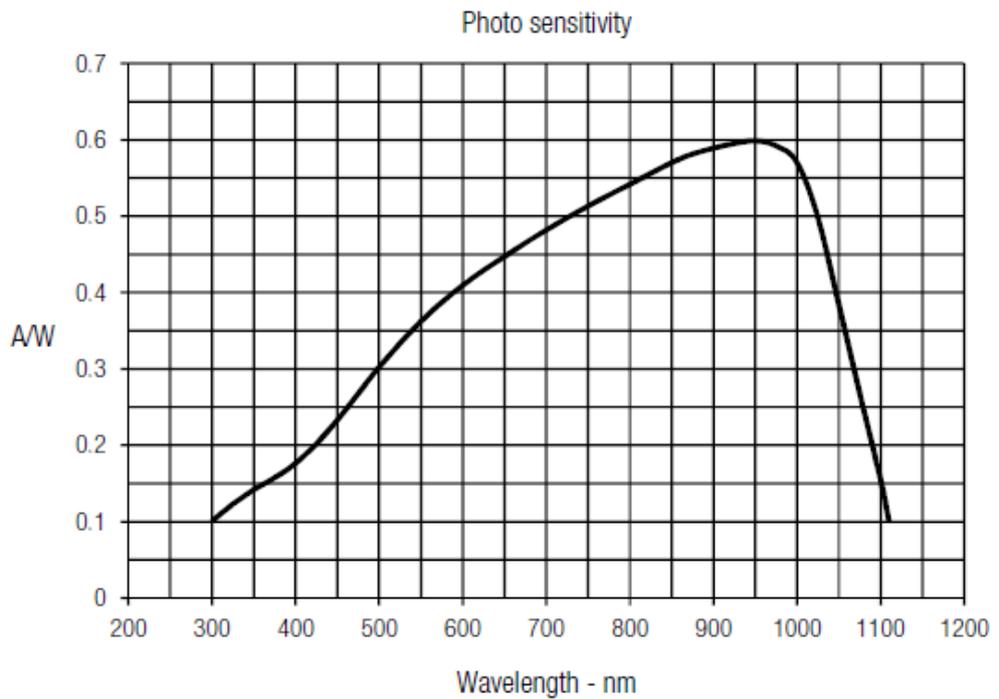
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Si フォトダイオード 有効エリア : 1.1 x 1.1 mm<sup>2</sup></li> <li>・ 超低ノイズ NEP 0.7 fW/√Hz</li> <li>・ 増幅器 トランスインピダンスゲイン 1 x 10<sup>12</sup> V/A</li> <li>・ 最大変換ゲイン 0.6 x 10<sup>12</sup> V/W</li> <li>・ 波長帯域 320 nm ~ 1100 nm</li> </ul>	
応用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蛍光測定</li> <li>・ 分光</li> <li>・ 電気泳動</li> <li>・ PMT、APD 置換え</li> </ul>	
仕様	テスト条件	電源電圧 Vs= ±15V, 環境温度 TA=25℃ ウォームアップ 20 分 (最短 10 分 推奨)
ゲイン	増幅器 トランスインピダンス 最大変換ゲイン	1 x 10 <sup>12</sup> V/A (@ ≥ 100 kΩ 負荷) 0.6 x 10 <sup>12</sup> V/W (@ 960 nm)
周波数応答性	カットオフ下限周波数 カットオフ上限周波数 (-3dB) 立上り/立下り時間(10-90%)	DC 20 Hz (±20 %) 18 ms (±20 %)
ディテクタ	ディテクタ アクティブエリア 波長応答	Siフォトダイオード 1.1 x 1.1 mm <sup>2</sup> 320 nm ~ 1100 nm
入力	光飽和パワー NEP	18 pW (@960nm, 線形増幅範囲) 0.7 fW/√Hz (@960nm, 1 Hz)



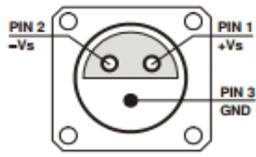
**Si フォトダイオード  
フェムトワット フォトレシーバ**

仕様(続き)		
出力	出力電圧	±10 V (@ ≥100kΩ負荷)
	出力インピダンス	50 Ω (設計負荷 ≥100kΩ)
	オフセット電圧	0 V, オフセットポテンショメータにて ±1.6 V 内で調整可
	最大出力電流	±25 mA
	出力ノイズ	計算値として、 40 mV <sub>p-p</sub> または 6 mV <sub>RMS</sub>
電源入力	電源電圧	±15V
	電源電流	±15 mA Typical 動作条件に依存。 パワーサプライ能力推奨 ±50mA 以上
ケース	重量	190 g (0.42 ポンド)
	材質	AlMg3/4.5Mn、ニッケルメッキ
温度条件	保管温度	-40 ~ +100 °C
	動作温度	0 ~ +60 °C
絶対入力限界	光入力パワー	10 mW
	電源電圧	±22V

スペクトル応答



**Si フォトダイオード  
フェムトワット フォトレシーバ**

コネクタ	<p>入力 25mm 円形フランジ (フリースペース用) (ファイバ入力は特注にて対応)</p> <p>出力 BNC, ジャック (メス)</p> <p>電源入力 Lemo 1Sシリーズ 3-pin (対応プラグタイプ: FFA.1S.303.CLAC52) Pin 1: + 15V Pin 2: - 15V Pin 3: GND</p> 
------	---

モデル	<p>FWPR-20-SI-FS フリースペース入力</p> <p>FWPR-S 特注バージョン</p>
-----	--

